








	<h2 style="color: #E67E22;">SIA433EDJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA433EDJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 12A SC-70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA433EDJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 78125 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA433EDJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 12A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	78125 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 12A (Tc) 3.5W (Ta), 19W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 7.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 8V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIA433EDJ-T1-GE3TR

SIA433EDJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA433EDJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA433EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA433EDJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA431DJ-T1-GE3 Vishay / Spectrol MOSFET P-CH 20V 12A PPAK SC70-6</p>	 <p>SIA431DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A PPAK SC70-6</p>	 <p>SIA436DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L</p>	 <p>SIA433EDJ VISHAY SIA433EDJ VISHAY</p>
 <p>SIA436DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L</p>	 <p>SIA432DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA437DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 29.7A SC70-6</p>	 <p>SIA432DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SIA415DJ-T1-GE3	↔ SIA417DJ-T1-GE3	⇒ SIA417DJ-T1-GE3	D SIA419DJ	⇒ SIA419DJ-T1-GE3
⊕ SIA419DJ-T1-GE3	⊕ SIA421DJ-T1-GE3	D SIA421DJ-T1-GE3	⇒ SIA425EDJ-T1-GE3	⇒ SIA425EDJ-T1-GE3
⊕ SIA426DJ-T1-GE3	⊕ SIA426DJ-T1-GE3	⊕ SIA427DJ-T1-GE3	↔ SIA427DJ-T1-GE3	⇒ SIA429DJ-T1-GE3
D SIA429DJ-T1-GE3	⊕ SIA430DJ-T1-GE3	⊕ SIA430DJ-T1-GE3	⊕ SIA431DJ	⇒ SIA431DJ-T1
⇒ SIA431DJ-T1-GE3	↔ SIA431DJ-T1-GE3	⊕ SIA432DJ-T1-GE3	⊕ SIA432DJ-T1-GE3	⇒ SIA433EDJ
↔ SIA433EDJ-T1-GE3	⇒ SIA436DJ-T1-GE3	D SIA436DJ-T1-GE3	⊕ SIA443DJ-T1-GE3	⊕ SIA443DJ-T1-GE3
⊕ SIA444DJ-T1-GE3	D SIA444DJ-T1-GE3	⇒ SIA445EDJ-T1-GE3	↔ SIA445EDJ-T1-GE3	⇒ SIA447DJ-T1-GE3
⊕ SIA447DJ-T1-GE3	⊕ SIA448DJ-T1-GE3	↔ SIA448DJ-T1-GE3	⇒ SIA449DJ-GE3	⇒ SIA450DJ-T1-GE3
⊕ SIA450DJ-T1-GE3	⊕ SIA4528-100K	⊕ SIA4528-330K	D SIA4528-470K	⇒ SIA453EDJ-T1-GE3
↔ SIA453EDJ-T1-GE3	⊕ SIA456DJ-T1-GE3	⊕ SIA456DJ-T1-GE3	⊕ SIA483DJ-T1-GE3	⇒ SIA483DJ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited